

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

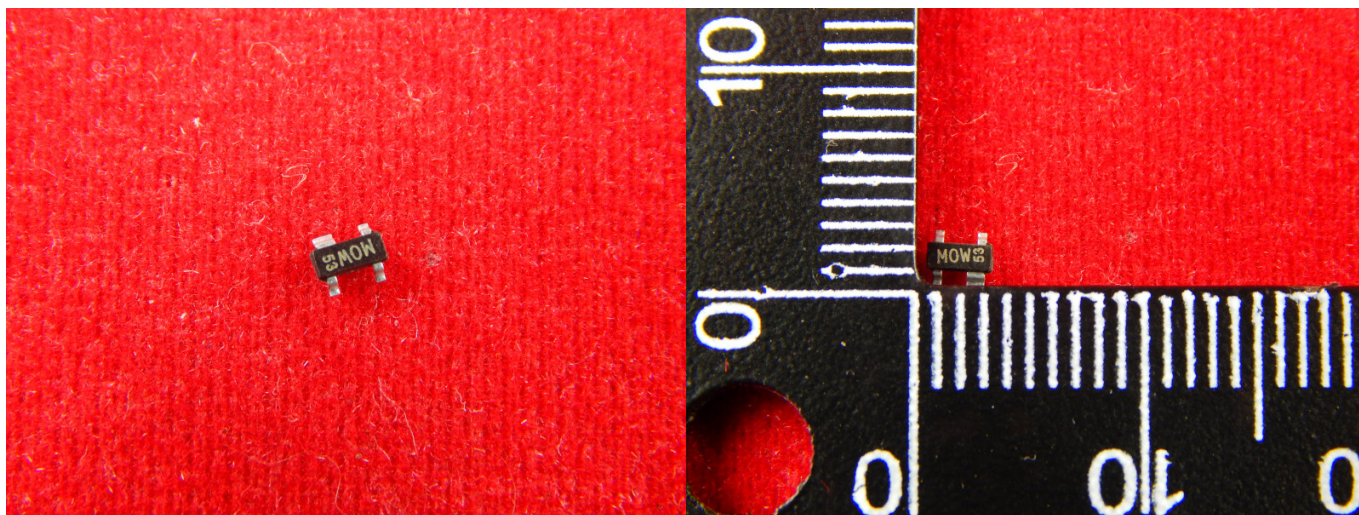
E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15686**

**Цена в прайсе: 275 тг.**

**Транзистор BF998R, 2N-канальный, SOT143R**



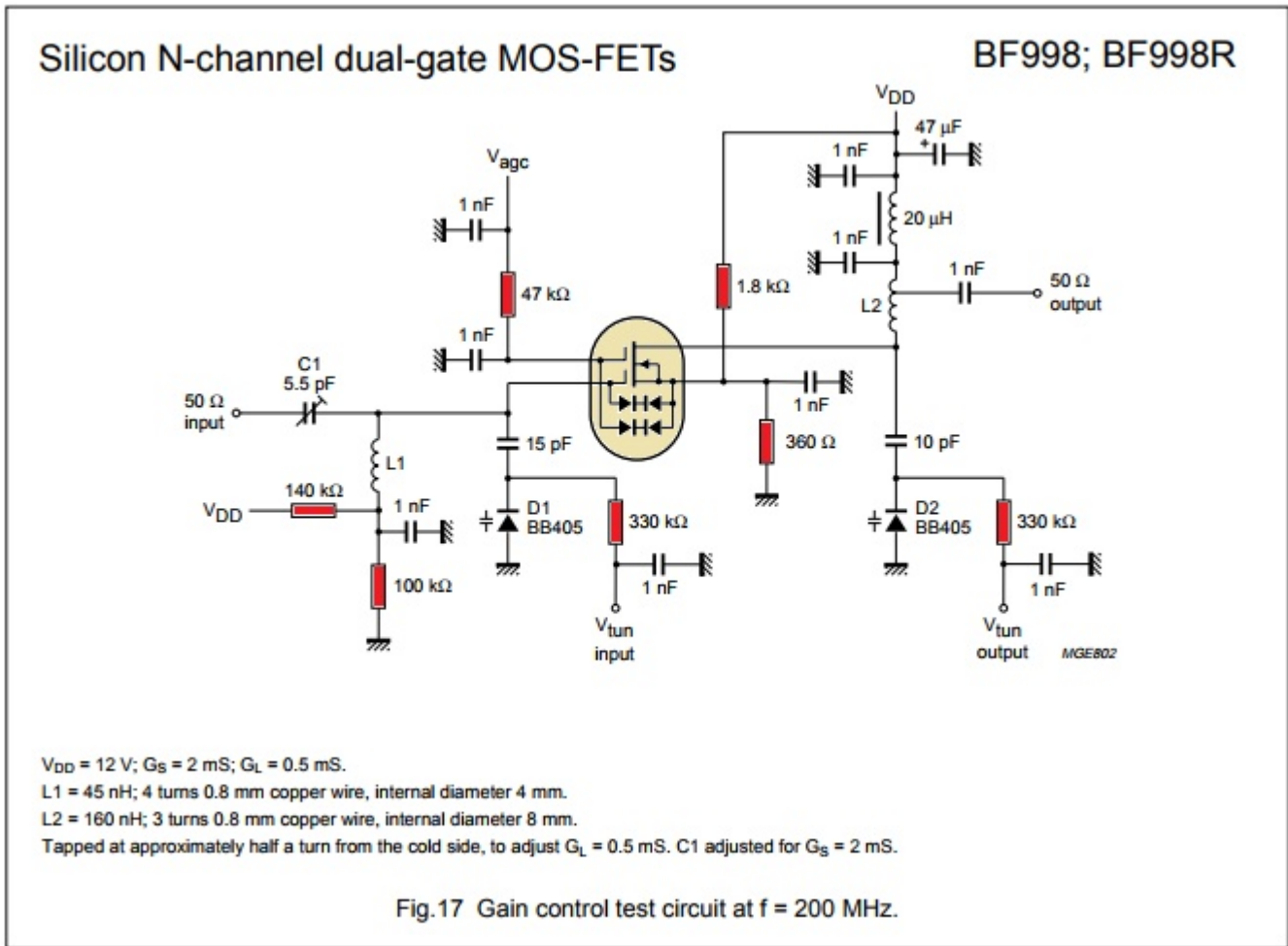
Транзистор — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет использовать его для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов.

BF998R является кремниевым, N-канальным МОП-транзистором с двумя затворами в корпусе SOT143R. Это полевой транзистор в пластиковом корпусе с взаимозависимыми источником и подложкой. Транзисторы защищены от бросков напряжения на входе при помощи диодов между затворами и источником. Обладает высоким соотношением полной переходной проводимостью к входной емкости и малошумящим усилителем до 1ГГц. BF998R используется в профессиональном оборудовании и телевизионных тюнерах.

#### **Спецификация:**

- Наименование прибора: BF998R;
- Тип транзистора: MOSFET;
- Полярность: N;
- Максимальная рассеиваемая мощность: 0.2 W;
- Предельно допустимое напряжение сток-исток: 12 V;
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток: 6 V;
- Максимально допустимый постоянный ток стока: 0.03 A;
- Максимальная температура канала: 150 °C;
- Выходная емкость: 2.5 pF;
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора: 200 Ohm;
- Тип корпуса: SOT143R.

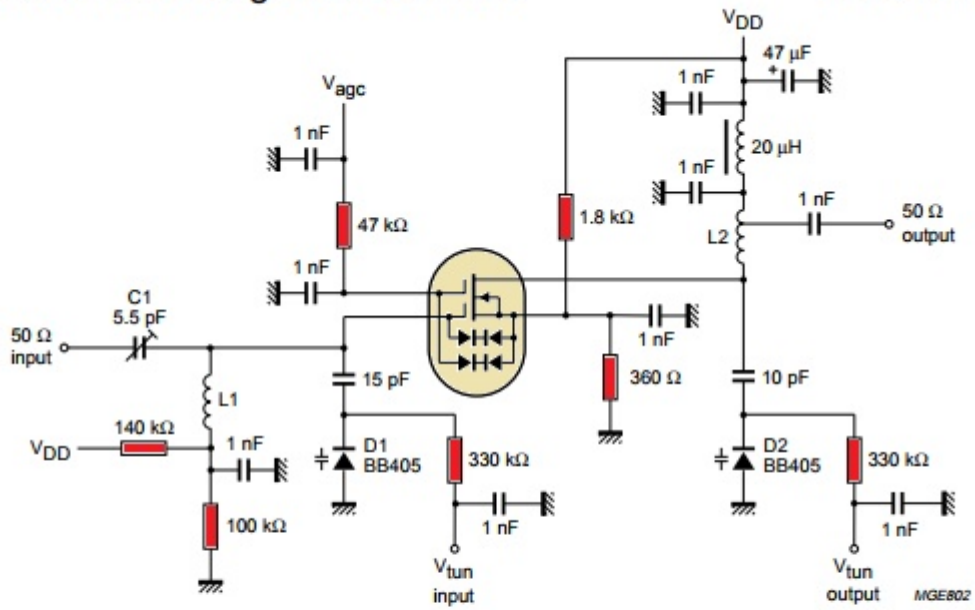
**Схема включения транзистора BF998R на частотах до 200 МГц:**



**Схема включения транзистора BF998R на частотах до 800 МГц:**

# Silicon N-channel dual-gate MOS-FETs

BF998; BF998R



$V_{DD} = 12\text{ V}$ ;  $G_S = 2\text{ mS}$ ;  $G_L = 0.5\text{ mS}$ .

$L1 = 45\text{ nH}$ ; 4 turns 0.8 mm copper wire, internal diameter 4 mm.

$L2 = 160\text{ nH}$ ; 3 turns 0.8 mm copper wire, internal diameter 8 mm.

Tapped at approximately half a turn from the cold side, to adjust  $G_L = 0.5\text{ mS}$ .  $C1$  adjusted for  $G_S = 2\text{ mS}$ .

Fig.17 Gain control test circuit at  $f = 200\text{ MHz}$ .